

2SC2277

シリコン NPN エピタキシャル LTP 形

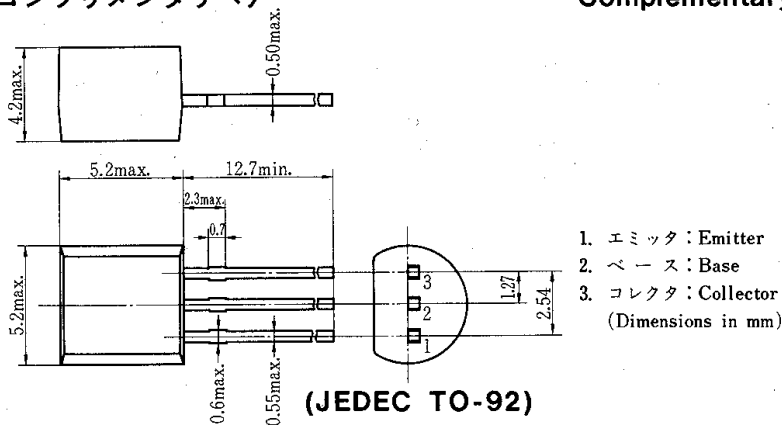
低周波増幅用

2SA993 とコンプリメンタリペア

SILICON NPN EPITAXIAL LTP

LOW FREQUENCY AMPLIFIER

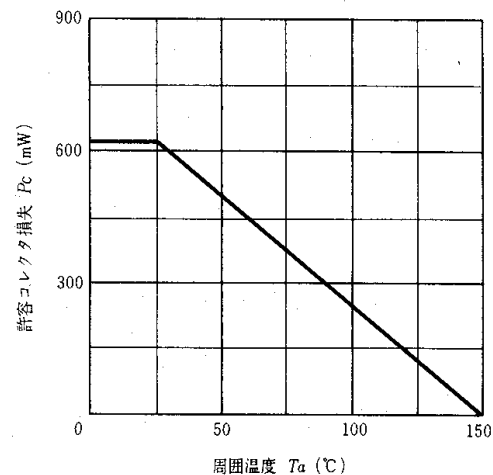
Complementary pair with 2SA993



■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SC2277	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	50	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	50	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	500	mA
許容コレクタ損失	P_C	625	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_C=10\mu\text{A}$, $I_E=0$	50	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C=1\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$	50	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=50\text{V}$, $I_E=0$	—	—	100	nA
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE}=3\text{V}$, $I_C=150\text{mA}$	60	—	320	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$	—	—	0.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=150\text{mA}$, $I_B=15\text{mA}$	—	—	0.5	V

* 2SC2277 は h_{FE} の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

* The 2SC2277 is grouped by h_{FE} as follows.

Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60~120	100~200	160~320